

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XT1224N7V0L1U	文件编号	XS-R-363
	瞬态电压抑制 (TVS) 二极管	版本号	18-A3-06
		页码	1/3

1 主要用途与主要特点

1.1 主要用途

用 W1XT1224N7V0L1U 封装的成品管主要用于 USB、手机、笔记本等电子设备的静电防护。

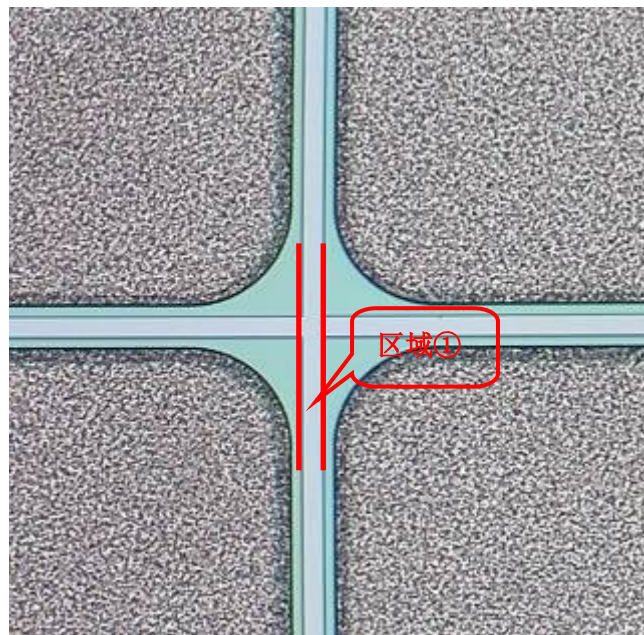
1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图 	芯片尺寸 (mm×mm)		1.5×1.0	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤150	
	划片道*尺寸 (μm)		40	
	键合区面积 (μm ²)	正面	1400×900	
		背面电极 (阴极)	金属	铝
	正面电极 (阳极)	厚度	5.0± 0.5	
		表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共
	硅片直径 (mm)		φ 125	
	键合要求 (推荐)		铜丝; φ 42 μm; 4 根	

* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片道区域, 宽度为 40 μm, 划片时应在两条参考线中间。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号
电话: (0510) 86851182

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真: (0510) 86851532



3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

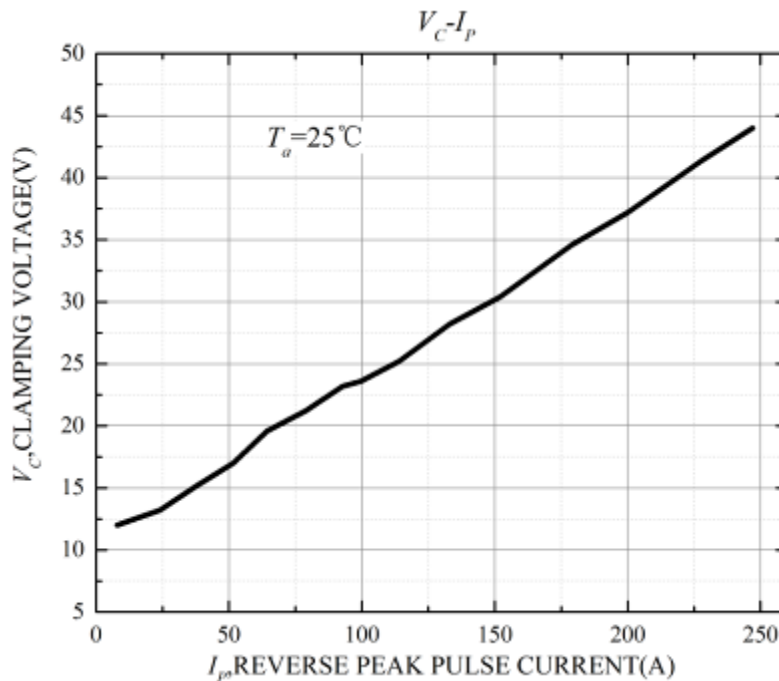
参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: DFN2020-3L 推荐成品: CESD7V0
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_z=1\text{mA}$	7.5	8.4	9.5	V
反向电流	I_R	$V_R=7\text{V}$	—	—	1	μA
正向电压	V_F	$I_F=20\text{mA}$	0.45	—	1.25	V
钳位电压	V_C	$I_{pp}=150\text{A}$ (8×20 μs)	—	30	45	V
结电容	C_{tot}	$V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$	—	1560	2000	pF

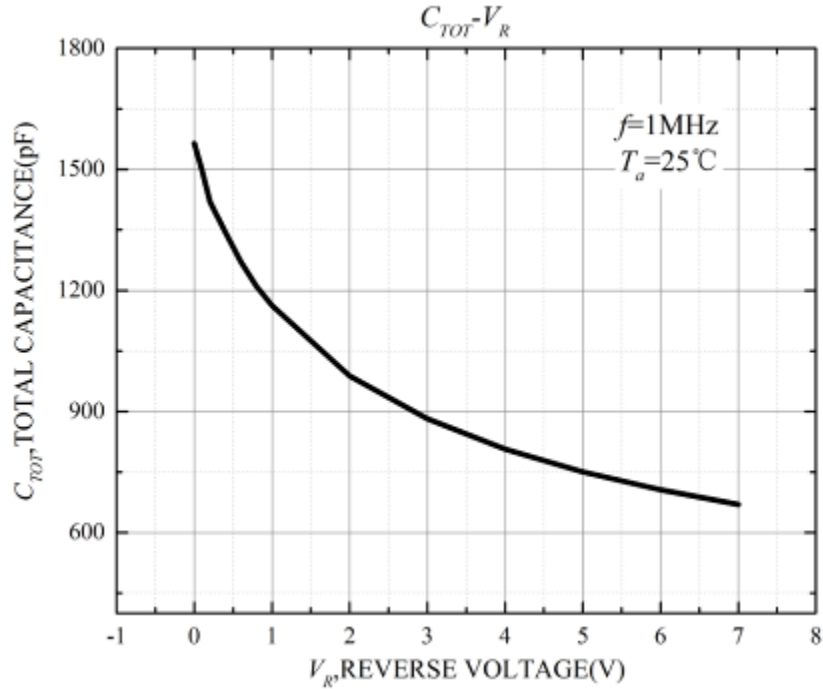
3.3 典型特性曲线





江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W1XT1224N7V0L1U
瞬态电压抑制 (TVS) 二极管

文件编号	XS-R-363
版本号	18-A3-06
页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25\pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电话：(0510) 86851182

网址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传真：(0510) 86851532